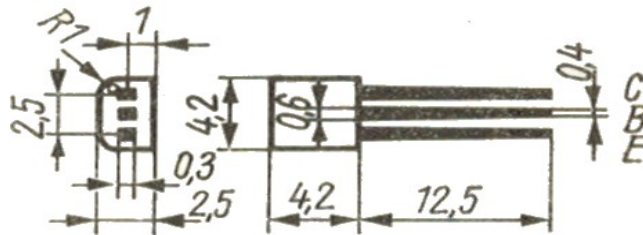


RFT SC236 – SC237 – SC238 - SC239

Silizium- npn- Transistoren für den Einsatz in NF- Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendungen

SC239 speziell für rauscharme Vor- und Treiberstufen



Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,5K/mW$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SC236	SC238	SC239	SC237
U_{CBO}	= 30V	30V	30V	50V
U_{CEO}	= 20V	20V	20V	45V
U_{EBO}	= 5V	5V	5V	6V
I_C	=		100mA	
I_B	=		10mA	
P_{tot}	= (bei $\vartheta_a = 25^\circ C$)		200mW	
ϑ_j	=		+125°C	
ϑ_a	=		-40 ... +100°C	

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ C -5K$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 30V$)	SC236, SC238, SC239	\leq	100nA
I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 50V$)	SC237	\leq	100nA
$U_{(BR)CEO}$	(bei $I_C = 10mA$)	SC236, SC238, SC239	\geq	20V
		SC237	\geq	45V
U_{CEsat}	(bei $I_C = 100mA, I_B = 5mA$) ¹⁾		typ.	210mV

¹⁾ Impulsmässige Messung

RFT SC236 – SC237 – SC238 - SC239

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$)

f_T		h_{21e}	Gruppe c	typ.	120MHz
(bei U_{CE}	= 6V,		d	typ.	145MHz
I_C	= 10mA		e	typ.	170MHz
f	= 20MHz)		f	typ.	210MHz
C_{11b}	($U_{EB} = 0,5\text{V}$, f = 1MHz)				7,7pF
C_{22b}	($U_{CB} = 6\text{V}$, f = 1MHz)				3,8pF
F	(bei $U_{CE} = 6\text{V}$, $I_C = 0,2\text{mA}$, f=1kHz)				
Δf	= 100Hz, $R_g = 2\text{k}\Omega$)		SC236		10dB
			SC237,SC238	≤	8dB
F	(bei $U_{CE} = 6\text{V}$, $I_C = 0,2\text{mA}$, $R_g = 2\text{k}\Omega$)				
f	= (0,03 ... 15)kHz		SC239	≤	4dB
h_{21e}			Gruppe c	=	56 ... 140
(bei $U_{CE} = 6\text{V}$,			d	=	112 ... 280
$I_C = 2\text{mA}$,			e	=	224 ... 560
f = 1kHz)			f	=	450 ... 1120

www.semicon-data.de

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985

www.semicon-data.de